

性能特点

- 频率范围: 2.7GHz~3.0GHz
- 功率增益: >40dB
- 饱和输出功率: > 51dBm
- 功率附加效率: 50%
- +28V /-5V
- 封装形式: QF2545-5

产品简介

HX2730P150W 是一种 GaN功率放大器模块, 其频率范围为2.7GHz~3.0GHz, 功率增益大于40dB, 饱和输出功率大于 51dBm, 工作电压 V_{DS} : +28V, V_{GS} : -5V。

电参数 ($T_C = +25^{\circ}C$, $V_{DS} = +28V$, $V_{GS} = -5V$)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2.7~3.0			GHz
功率增益	40	42		dB
增益平坦度			±1	dB
饱和输出功率	51	52		dBm
功率附加效率	50	58		%
外形尺寸	45.0mm×25.0mm×5.3mm			

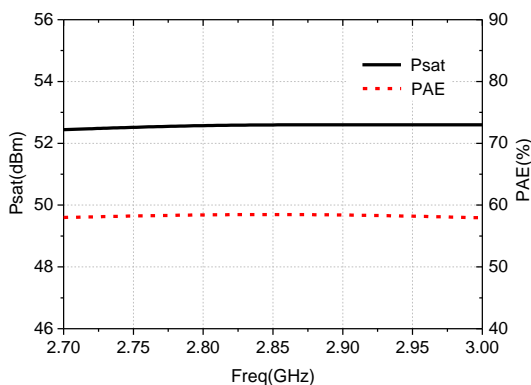
注: 射频测试条件: $V_{DS} = +28V$, $V_{GS} = -5V$, $P_{in} = +10dBm$, 脉宽: 3ms, 占空比: 30%; 先加栅压, 后加漏压。

极限参数

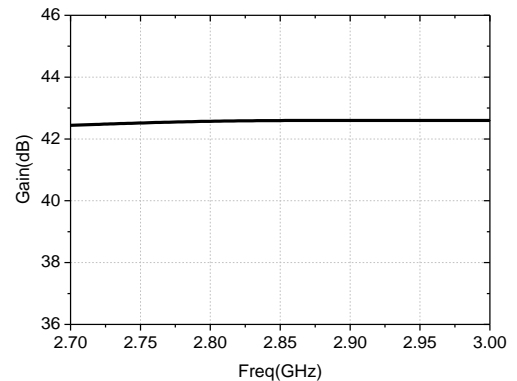
最大漏源正电压	+36V
最高输入功率	+14dBm
储存温度	-55°C ~ +120°C
使用温度	-45°C ~ +70°C

典型曲线

饱和输出功率/效率 vs. 频率



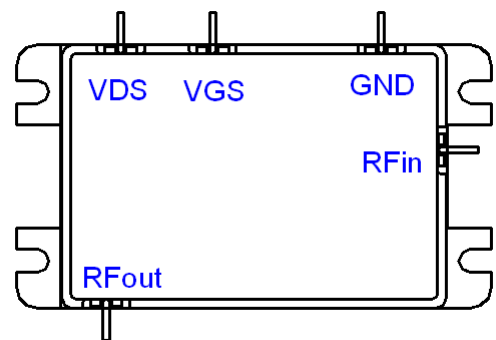
功率增益 vs. 频率



外形尺寸

HX2730P150W 型 GaN 放大器模块的外形尺寸及固定孔位置: 见 QF2545-5 封装。

引出端排列图



引脚号	符号	功能
1	V_{GS}	栅源电源端口
2	RF_{in}	射频信号输入端
3	RF_{out}	射频信号输出端
4	V_{DS}	漏源电源端口
5	GND	接地

使用方法与注意事项

使用时将器件紧贴盒体底部用螺丝固定。特别提示, 该器件为静电敏感器件, 操作时请严防静电。

注: 模块外形尺寸及性能指标可按用户要求定制。

封装形式: QF2545-5

